

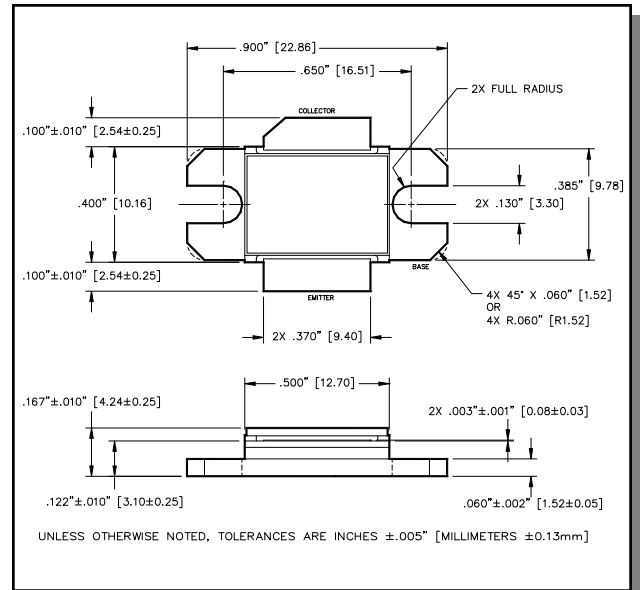
Radar Pulsed Power Transistor
 115W, 2.7-2.9 GHz, 200µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
 PRELIMINARY, 10 Aug 07

Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant
- Device marked as PR2731-115M

Outline Drawing



Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	65	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	TBD	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	TBD	W
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 40\text{mA}$		BV_{CES}	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 36\text{V}$		I_{CES}	-	7.5	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	$R_{TH(JC)}$	-	TBD	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	P_{OUT}	115	-	W
Power Gain	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	G_P	7.6	-	dB
Gain Flatness	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	ΔG	-	1.0	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	η_C	38	-	%
Pulse Droop	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	Droop	-	0.5	dB
Input Return Loss	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	RL	-	-10	dB
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	VSWR-T	-	2:1	-
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 20\text{W}$	F = 2.7, 2.9, 3.1 GHz	VSWR-S	-	1.5:1	-

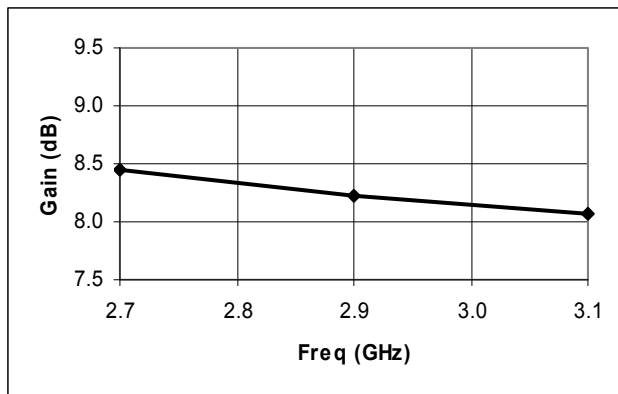
Radar Pulsed Power Transistor
115W, 2.7-2.9 GHz, 200µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
PRELIMINARY, 10 Aug 07

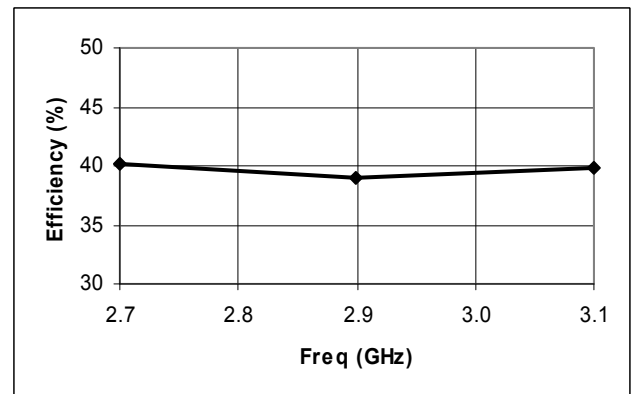
Typical RF Performance

Freq. (GHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	ΔGain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	Droop (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (2:1)
2.7	20	140	8.45	-	9.16	40.1	-11.8	0.00	S	P
2.9	20	133	8.23	-	8.97	38.9	-16.6	0.12	S	P
3.1	20	128	8.06	0.39	8.49	39.8	-15.3	0.26	S	P

Gain vs. Frequency



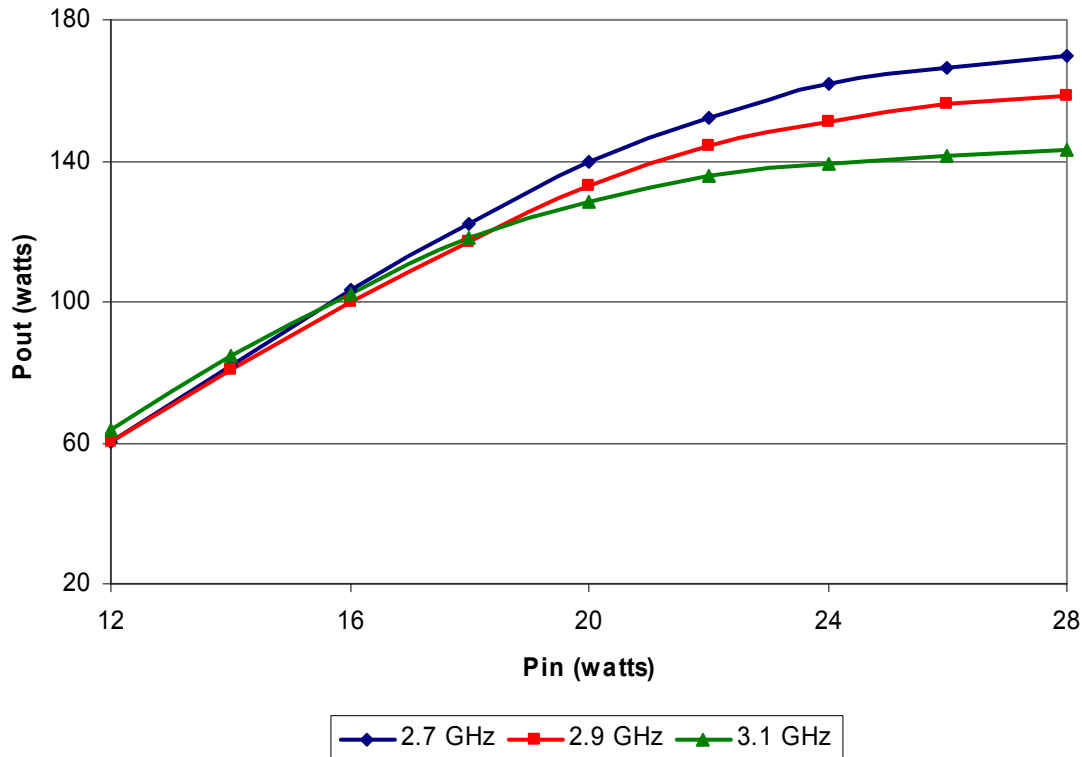
Collector Efficiency vs. Frequency



Radar Pulsed Power Transistor
115W, 2.7-2.9 GHz, 200µs Pulse, 10% Duty

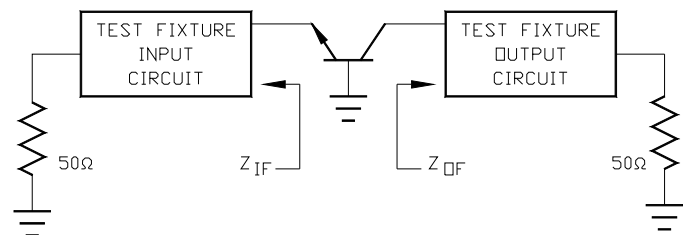
M/A-COM Products
PRELIMINARY, 10 Aug 07

RF Power Transfer Curve (Output Power Vs. Input Power)



RF Test Fixture Impedance

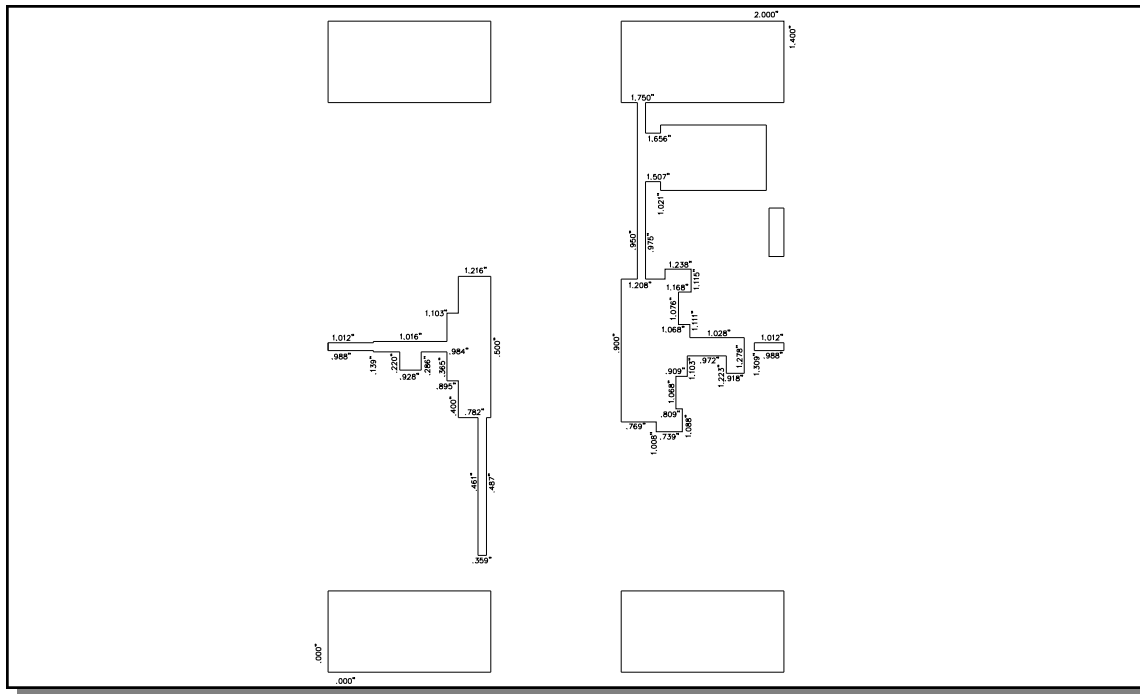
F (GHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
2.7	4.7 - j6.1	2.4 - j2.4
2.8	4.5 - j5.8	2.4 - j2.2
2.9	4.4 - j5.7	2.4 - j2.0
3.0	4.3 - j5.5	2.4 - j1.8
3.1	4.1 - j5.3	2.4 - j1.6



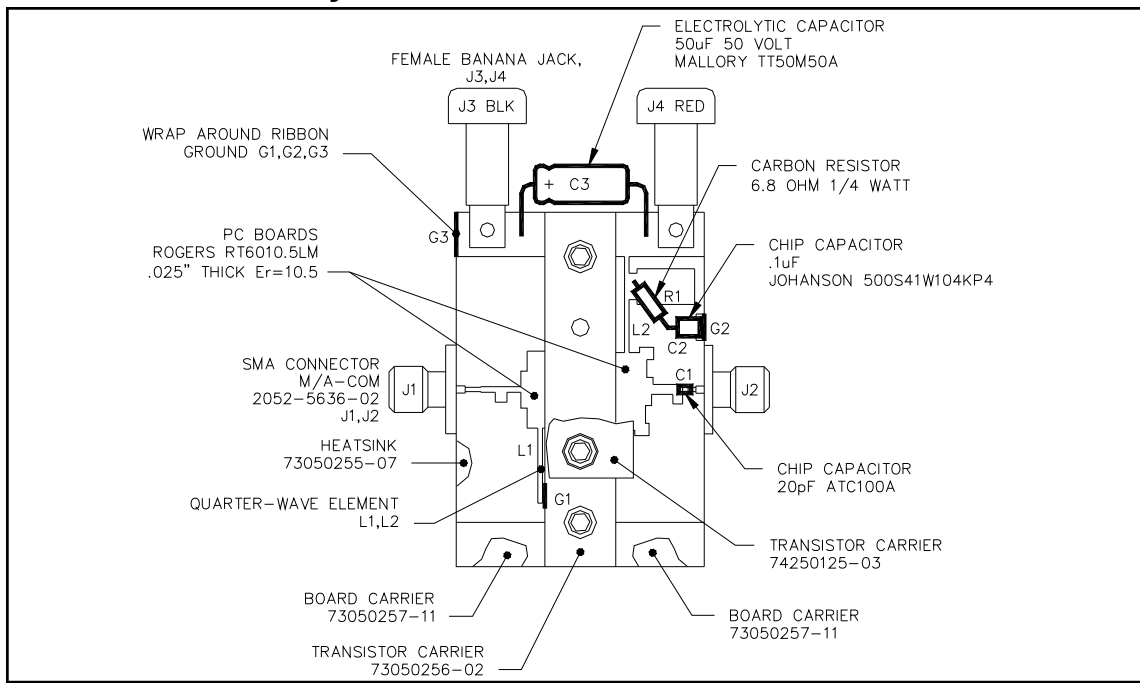
Radar Pulsed Power Transistor
115W, 2.7-2.9 GHz, 200µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
PRELIMINARY, 10 Aug 07

Test Fixture Circuit Dimensions



Test Fixture Assembly



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9